

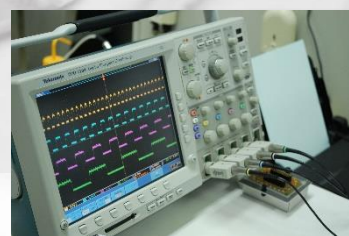
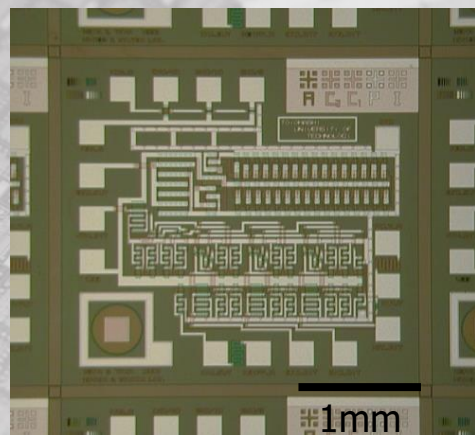
集積回路技術講習会

nMOS集積回路の製作と集積回路設計の基礎

日程

2025年7月28日(月)～8月1日(金)

- ✓ 1人1枚のSiウェハを持ってリングオシレータ、4bit カウンタなどを含むIC製作と評価を行う
- ✓ 待ち時間の長いプロセス(酸化やCVD工程)を利用して、基礎から最先端にわたる半導体・集積回路の講義を実施
- ★ 単に製作するだけでなく基礎的な理解に始まってLSIの全体像をより広く理解できるようなカリキュラム構成



申し込み
お問い合わせ

社会連携推進センター
jinzai@office.tut.ac.jp

詳細

<http://www.int.ee.tut.ac.jp/ic/>



「第 43 回集積回路技術講習会」のご案内

本学では、夏休みを利用して、社会人の方々を対象とした集積回路技術講習会を毎年開催しております。

本講習会は、本学がかかげる建学の精神『産学共同』の一環として、大学では類を見ない充実した半導体教育研究設備と長年にわたって蓄積して来た数々の優れた教育研究成果を学外の方に活用していただくためのものです。

今年度は下記の概要で開催を予定しております。多くの方々にご参加いただきたくご案内申し上げます。

記

1. 日 時： 2025 年 7 月 28 日(月)～8 月 1 日(金) の 5 日間、午前 9 時～午後 7 時
2. 会 場：国立大学法人 豊橋技術科学大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー (VBL)
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1
3. 内 容：テーマ「**n-MOS 集積回路の製作と集積回路設計の基礎**」
－各自の Si ウエハで IC の作製と計測・評価を行う－
 - (1) nMOS デバイスと IC の作製
リングオシレータ, 4 ビットカウンタ, インバータ, D-TYPE MOSFET, E-TYPE MOSFET, C-V 特性用 MOS ダイオード
 - (2) 講義【**集積回路製造・設計技術の基礎**】
集積回路製造技術の基礎, MOS デバイスの基礎と応用, 最新の集積回路技術
4. 詳細日程：「**集積回路技術講習会**」web サイトを参照ください。
<http://www.int.ee.tut.ac.jp/ic/>
5. 定 員：10 名
6. 参加費：35 万円（税込み）／名
7. 申し込み：2025 年 6 月 13 日（金）まで(定員に達ししだい締め切り)
別紙「参加申込書」に必要事項記入のうえ、E-mail (jinzai@office.tut.ac.jp：社会連携推進センター／研究推進課 産学連携係) にてお申込み下さい。

主 催：豊橋技術科学大学 次世代半導体・センサ科学研究所

共 催：豊橋技術科学大学 社会連携推進センター





国立大学法人 豊橋技術科学大学
社会人向け「第 43 回集積回路技術講習会」
(2025 年 7 月 28 日～8 月 1 日)

参加申込書 (〆切: 2025 年 6 月 13 日)

下記のとおり参加を申込みます。

1. 申込日	2025 年 月 日
2. 参加者氏名	
2. フリガナ	
3. 所属・団体名	
4. 部署名	
5. 勤務先住所	〒
6. 電話番号	
7. 電子メール	(半角英数字)

【ご意見・ご要望】(あればご自由に記載ください)

ご記入漏れがないか再度ご確認ください。E-mail にて以下まで送信ください。

【送信先】

・E-mail: jinzai@office.tut.ac.jp : 社会連携推進センター／研究推進課 産学連携係